

**N-沟道功率 MOS 管/ N-CHANNEL POWER MOSFET**

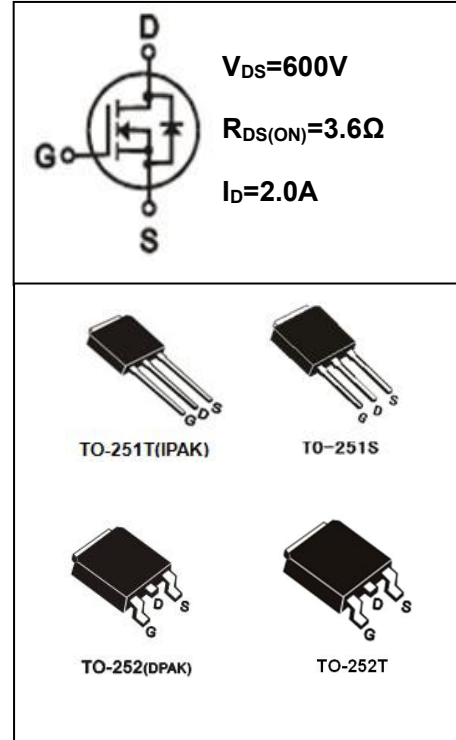
**SIF2N60F**

- 特点：导通电阻低 开关速度快 输入阻抗高 符合RoHS规范
- FEATURES: ■LOW ON-RESISTANCE ■FAST SWITCHING ■HIGH INPUT RESISTANCE ■RoHS COMPLIANT
- 应用：电子镇流器 电子变压器 开关电源
- APPLICATION: ■ELECTRONIC BALLAST■ELECTRONIC TRANSFORMER■SWITCH MODE POWER SUPPLY

●最大额定值 (Tc=25°C)

●Absolute Maximum Ratings (Tc=25°C) TO-251T/251S/252/252T

参数 PARAMETER	符号 SYMBOL	额定值 VALUE	单位 UNIT
漏-源电压 Drain-source Voltage	V <sub>DS</sub>	600	V
栅-源电压 gate-source Voltage	V <sub>GS</sub>	±30	V
漏极电流 Continuous Drain Current TC=25°C	I <sub>D</sub>	2.0*	A
漏极电流 Continuous Drain Current TC=100°C	I <sub>D</sub>	1.25*	A
最大脉冲电流 Drain Current — Pulsed ①	I <sub>DM</sub>	8.0*	A
耗散功率 Power Dissipation	P <sub>tot</sub>	44	W
最高结温 Junction Temperature	T <sub>J</sub>	150	°C
存储温度 Storage Temperature	T <sub>STG</sub>	-55-150	°C
单脉冲雪崩能量 Single Pulse Avalanche Energy ②	E <sub>AS</sub>	76	mJ



\*漏极电流由最高结温限制

\*Drain current limited by maximum junction temperature

●电特性 (Tc=25°C)

●Electronic Characteristics (Tc=25°C)

参数 PARAMETER	符号 SYMBOL	测试条件 TEST CONDITION	最小值 MIN	典型值 TYP	最大值 MAX	单位 UNIT
漏-源击穿电压 Drain-source Breakdown Voltage	BV <sub>DSS</sub>	V <sub>GS</sub> =0V, I <sub>D</sub> =250μA	600			V
击穿电压温度系数 Breakdown Voltage Temperature Coefficient	ΔBV <sub>DSS</sub> / ΔT <sub>J</sub>	I <sub>D</sub> =250uA, Referenced to 25°C		0.6		V/°C
栅极开启电压 Gate Threshold Voltage	V <sub>GS(TH)</sub>	V <sub>GS</sub> =V <sub>DS</sub> , I <sub>D</sub> =250μA	2.0		4.0	V
漏-源漏电流 Drain-source Leakage Current	I <sub>DSS</sub>	V <sub>DS</sub> =600V, V <sub>GS</sub> =0V, T <sub>J</sub> =25°C			1	μA
		V <sub>DS</sub> =480V, V <sub>GS</sub> =0V, T <sub>J</sub> =125°C			100	μA
跨导 Forward Transconductance	g <sub>fs</sub>	V <sub>DS</sub> =15V, I <sub>D</sub> =1A ③		1.5		S

●订单信息/ORDERING INFORMATION:

包装形式/PACKING	订货编码/ORDERING CODE	
	普通塑封料 Normal Package Material	无卤塑封料 Halogen Free
TO-252(T)或 251T 或 251S 条管装 TUBE PACKING	SIF2N60F TO-251T-TU 或 TO-251S-TU 或 TO-252(T)-TU	SIF2N60F TO-251T-TU-HF 或 TO-251S-TU 或 TO-252(T)-TU-HF
TO-252(T) 编带装/TAPE & REEL PACKING	SIF2N60F TO-252(T)-TR	SIF2N60F TO-252(T)-TR-HF



**N-沟道功率 MOS 管/ N-CHANNEL POWER MOSFET**

**SIF2N60F**

参数 PARAMETER	符号 SYMBOL	测试条件 TEST CONDITION	最小值 MIN	典型值 TYP	最大值 MAX	单位 UNIT
栅极漏电流 Gate-body Leakage Current ( $V_{DS} = 0$ )	$I_{GSS}$	$V_{GS} = \pm 30V$			$\pm 100$	nA
漏-源导通电阻 Static Drain-source On Resistance	$R_{DS(ON)}$	$V_{GS} = 10V, I_D = 1A$ ③		3.6	4.5	$\Omega$
输入电容 Input Capacitance	$C_{iss}$	$V_{GS} = 0V, V_{DS} = 25V$ $F = 1.0MHz$		278		pF
输出电容 Output Capacitance	$C_{oss}$			20		
反向传输电容 Reverse transfer Capacitance	$C_{rss}$			5		
关断延迟 Turn -Off Delay Time	$T_d(off)$	$V_{DD} = 300V, I_D = 2.0A$ $R_G = 25\Omega$ ③		24		ns
栅极电荷 Total Gate Charge	$Q_g$	$I_D = 2.0A, V_{DS} = 480V$ $V_{GS} = 10V$ ③		6.6		nC
栅源电荷 Gate-to-Source Charge	$Q_{gs}$			1.4		nC
栅漏电荷 Gate-to-Drain Charge	$Q_{gd}$			2.0		nC
二极管正向电流 Continuous Diode Forward Current	$I_s$				2.0	A
二极管正向压降 Diode Forward Voltage	$V_{SD}$	$T_j = 25^\circ C, I_s = 2.0A$ $V_{GS} = 0V$ ③			1.4	V
反向恢复时间 Reverse Recovery Time	$t_{rr}$	$T_j = 25^\circ C, I_f = 2.0A$ $di/dt = 100A/\mu s$ ③		120		ns
反向恢复电荷 Reverse Recovery Charge	$Q_{rr}$			0.6		$\mu C$

● 热特性

● Thermal Characteristics

参数 PARAMETER	符号 SYMBOL	最大值 MAX	单位 UNIT
热阻结-壳 Thermal Resistance Junction-case	$R_{thJC}$	2.87	$^\circ C/W$
热阻结-环境 Thermal Resistance Junction-ambient	$R_{thJA}$	110.0	$^\circ C/W$

注释(Notes):

- ① 脉冲宽度：以最高结温为限制  
Repetitive rating: Pulse width limited by maximum junction temperature
- ② 初始结温=25 $^\circ C$ ,  $V_{DD} = 50V$ ,  $L = 36mH$ ,  $R_G = 25\Omega$ ,  $I_{AS} = 2.0A$   
Starting  $T_j = 25^\circ C$ ,  $V_{DD} = 50V$ ,  $L = 36mH$ ,  $R_G = 25\Omega$ ,  $I_{AS} = 2.0A$
- ③ 脉冲测试：脉冲宽度 $\leq 300\mu s$ ，占空比 $\leq 2\%$   
Pulse Test : Pulse width  $\leq 300\mu s$ , Duty cycle  $\leq 2\%$

N-沟道功率 MOS 管/ N-CHANNEL POWER MOSFET

SIF2N60F

● 特性曲线

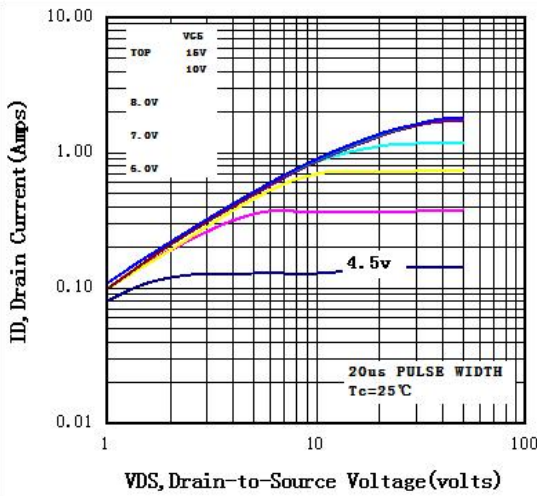


图 1 输出特性曲线, Tc=25°C

Fig1 Typical Output Characteristics, Tc=25°C

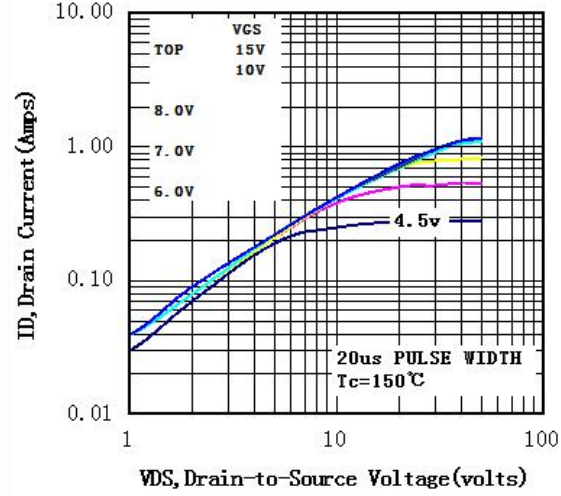


图 2 输出特性曲线, Tc=150°C

Fig2 Typical Output Characteristics, Tc=150°C

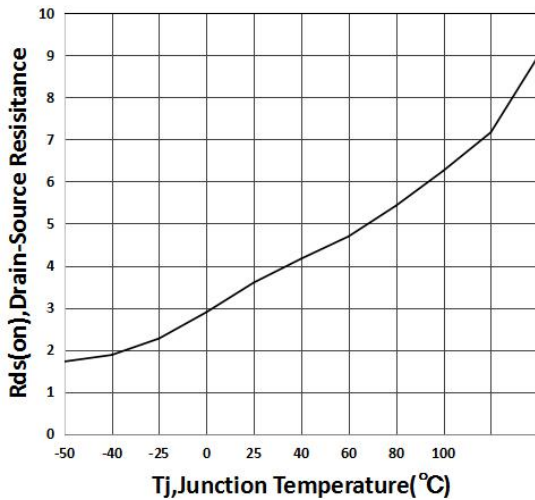


图 3 归一化导通电阻与温度曲线

Fig3 Normalized Resistance Vs. Temperature

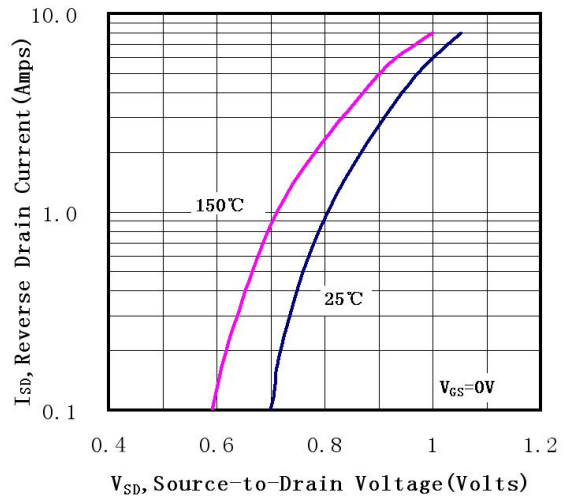


图 4 二极管正向压降曲线

Fig4 Typical Source-Drain Diode Forward Voltage

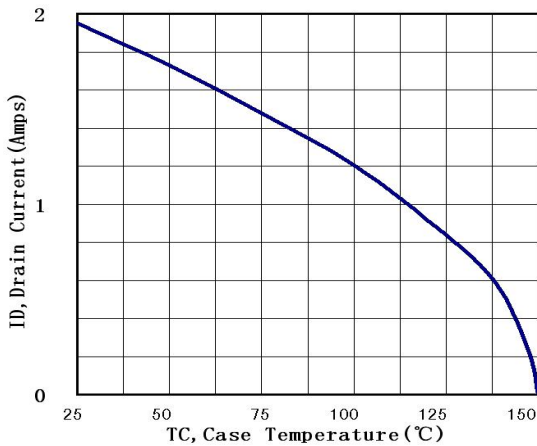


图 5 最大漏极电流与壳温曲线

Fig5 Maximum Drain Current Vs. Case Temperature

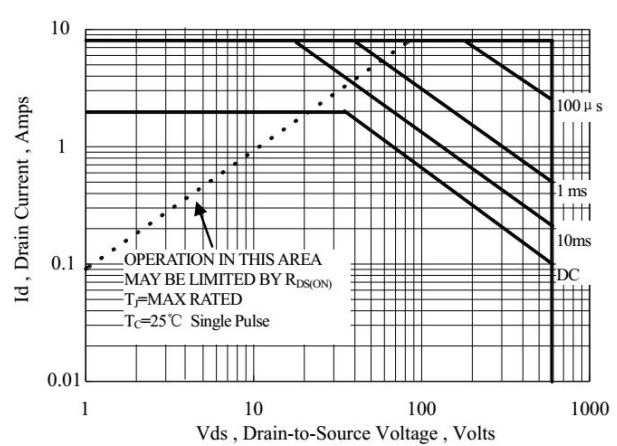


图 6 最大安全工作区曲线

Fig6 Maximum Safe Operating Area

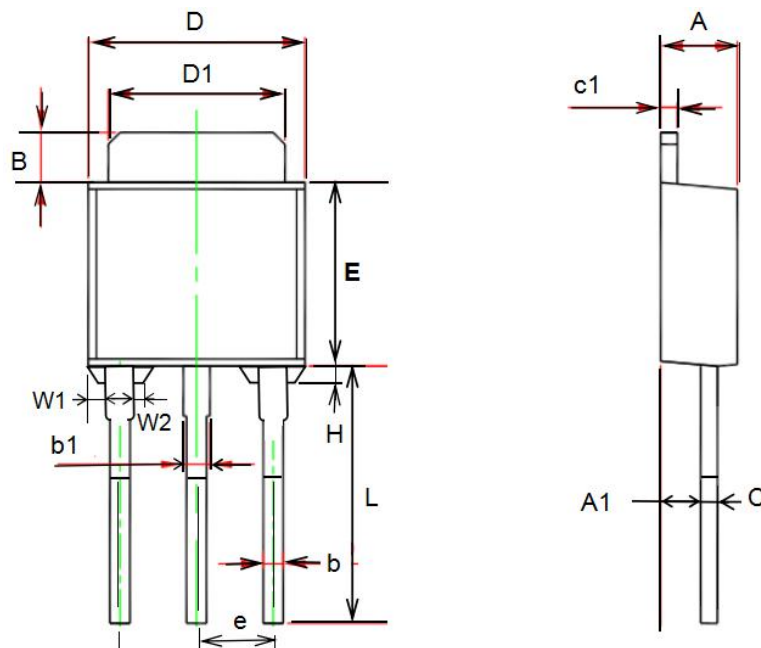


## TO-251T 封装机械尺寸 TO-251T (IPAK) MECHANICAL DATA

单位:毫米/UNIT: mm

符号/SYMBOL	最小值/min	典型值/nom	最大值/max
A	2.10		2.50
A <sub>1</sub>	0.95		1.30
B	0.80		1.25
b	0.50		0.80
b <sub>1</sub>	0.70		0.80
c	0.45		0.70
c <sub>1</sub>	0.45		0.70
D	6.35		6.80
D <sub>1</sub>	5.10		5.50
E	5.30		6.30
e	2.25	2.30	2.35
L	7.00		9.20
H	0.35		0.45
W <sub>1</sub>	0.30		0.50
W <sub>2</sub>	0.20		0.40

[S/L]

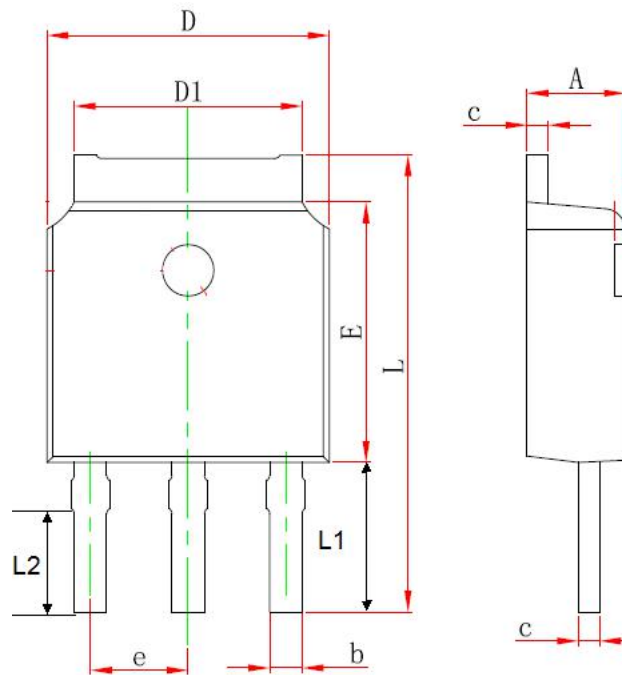




## TO-251S 封装机械尺寸 TO-251S (IPAK) MECHANICAL DATA

单位:毫米/UNIT: mm

符号/SYMBOL	最小值/min	典型值/nom	最大值/max
A	2.20		2.40
b	0.50		0.85
C	0.45	0.50	0.60
D	6.50		6.70
D1	5.10		5.50
E	5.9		6.20
e	2.18	2.29	2.38
L	11.00		12.40
L1	4.8		5.3
L2	3.5		4.2

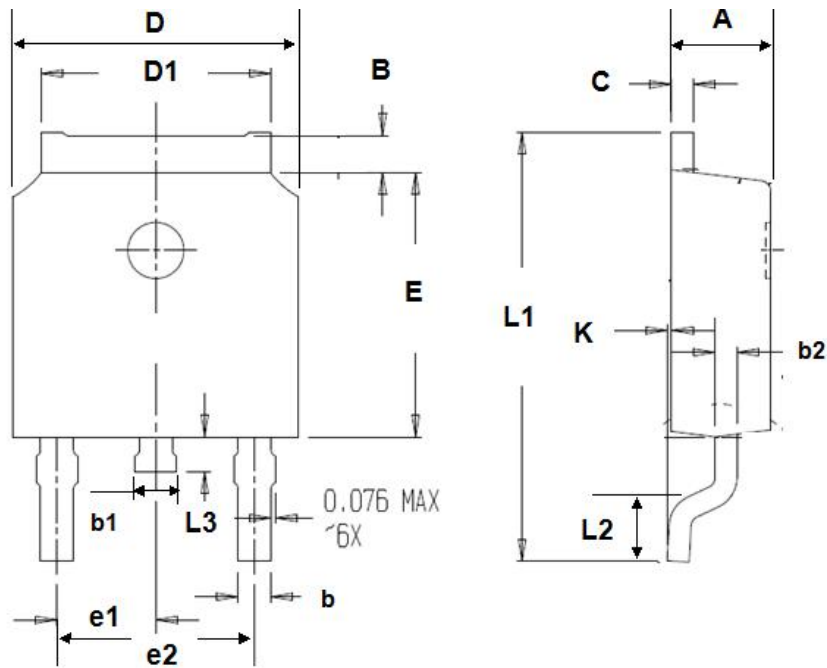




## TO-252 封装机械尺寸 TO-252 MECHANICAL DATA

单位:毫米/UNIT: mm

符号 SYMBOL	最小值 min	最大值 max	符号 SYMBOL	最小值 min	最大值 max
A	2.10	2.50	B	0.85	1.25
b	0.50	0.80	b1	0.50	0.90
b2	0.45	0.70	C	0.45	0.70
D	6.30	6.75	D1	5.10	5.50
E	5.30	6.30	e1	2.25	2.35
L1	9.20	10.60	e2	4.45	4.75
L2	0.90	1.75	L3	0.60	1.10
K	0.00	0.23			

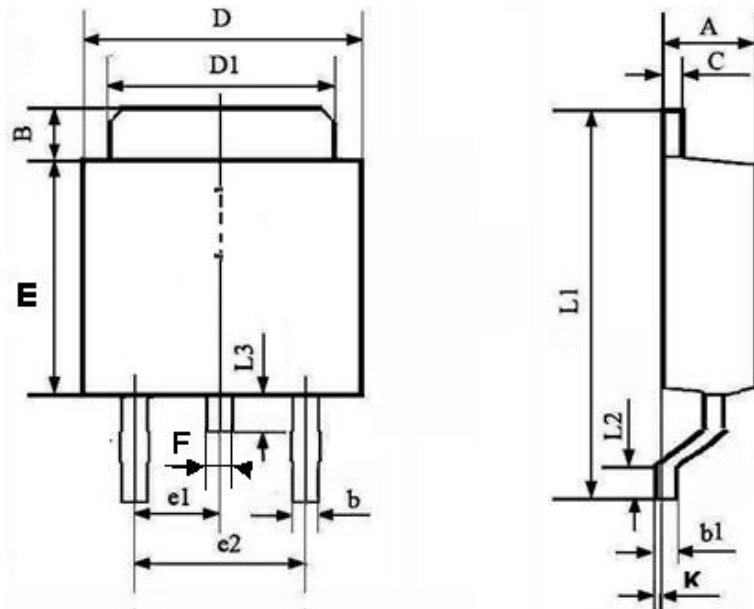




## TO-252T 封装机械尺寸 TO-252T MECHANICAL DATA

单位:毫米/UNIT: mm

符号 SYMBOL	最小值 min	最大值 max	符号 SYMBOL	最小值 min	最大值 max
A	2.20	2.40	B	0.85	1.25
b	0.50	0.80	C	0.45	0.70
b1	0.45	0.70	D	6.30	6.70
D1	5.10	5.50	E	5.30	6.20
L1	9.20	10.60	F	0.50	0.90
L2	0.90	1.50	e1	2.25	2.35
L3	0.60	1.10	e2	4.50	4.70
			K	0.00	0.18



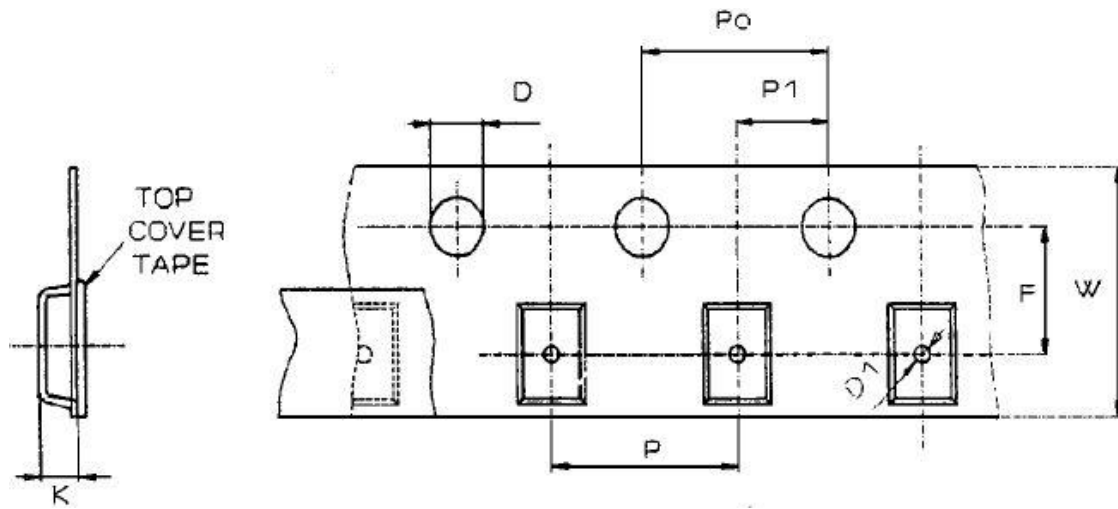
[L]



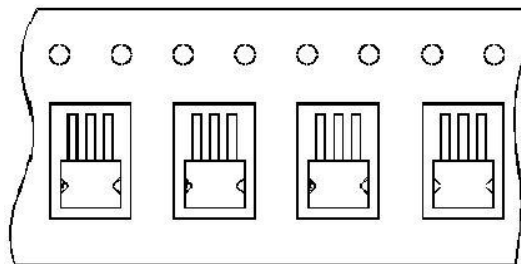
## TO-252 编带规格尺寸 TO-252 TAPE AND REEL DATA

单位:毫米/UNIT: mm

符号 SYMBOL	最小值 min	最大值 max	符号 SYMBOL	最小值 min	最大值 max
W	16.0-0.3	16.0+0.3	F	7.5-0.1	7.5+0.1
P0	4.0-0.1	4.0+0.1	D	1.5-0.0	1.5+0.1
P	8.0-0.1	8.0+0.1	P1	2.0-0.1	2.0+0.1
K	2.65	2.80	D1	1.5-0.0	1.5+0.1



使用供带方向/USER DIRECTION OF FEED



编带器件定位/UNIT ORIENTATION



## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [MOSFET](#) category:*

*Click to view products by [SI](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[614233C](#) [648584F](#) [IRFD120](#) [IRFF430](#) [JANTX2N5237](#) [2N7000](#) [FCA20N60\\_F109](#) [FDZ595PZ](#) [AOD464](#) [2SK2267\(Q\)](#) [2SK2545\(Q,T\)](#)  
[405094E](#) [423220D](#) [MIC4420CM-TR](#) [VN1206L](#) [614234A](#) [715780A](#) [SSM6J414TU,LF\(T](#) [751625C](#) [PSMN4R2-30MLD](#)  
[TK31J60W5,S1VQ\(O](#) [2SK2614\(TE16L1,Q\)](#) [DMN1017UCP3-7](#) [EFC2J004NUZTDG](#) [FCAB21350L1](#) [P85W28HP2F-7071](#) [DMN1053UCP4-7](#)  
[NTE2384](#) [NTE2969](#) [NTE6400A](#) [DMN2080UCB4-7](#) [DMN61D9UWQ-13](#) [US6M2GTR](#) [DMN31D5UDJ-7](#) [SSM6P54TU,LF](#) [DMP22D4UFO-](#)  
[7B](#) [IPS60R3K4CEAKMA1](#) [DMN1006UCA6-7](#) [DMN16M9UCA6-7](#) [STF5N65M6](#) [STU5N65M6](#) [C3M0021120D](#) [DMN13M9UCA6-7](#)  
[BSS340NWH6327XTSA1](#) [MCM3400A-TP](#) [DMTH10H4M6SPS-13](#) [IRF40SC240ARMA1](#) [IPS60R1K0PFD7SAKMA1](#)  
[IPS60R360PFD7SAKMA1](#) [IPS60R600PFD7SAKMA1](#)